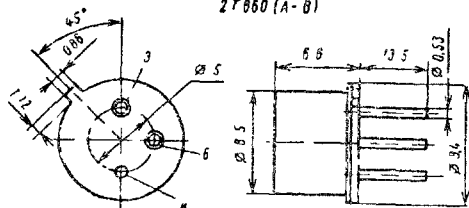


# 2Т860 (А, Б, В)

2Т860 (А-В)



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилителях мощности, преобразователях. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и гибкими выводами.

Масса транзистора не более 2 г

## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при

$U_{КЭ} = 2 \text{ В}$ ,  $I_K = 1 \text{ А}$ :

$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$ :

2Т860А	40	160
2Т860Б	50	200
2Т860В	80	300

$T = +125 \text{ }^\circ\text{C}$ :

2Т860А	40	200
2Т860Б	50	250
2Т860В	80	400

$T = -60 \text{ }^\circ\text{C}$ :

2Т860А	20	160
2Т860Б	25	200
2Т860В	40	300

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КБ} = 5 \text{ В}$ ,  $I_D = 0,05 \text{ А}$ , не менее

10 МГц

Граничное напряжение при  $I_K = 100 \text{ мА}$ , не менее:

2Т860А	80 В
2Т860Б	60 В
2Т860В	30 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при  $I_K = 1 \text{ А}$ ,  $I_E = 0,2 \text{ А}$ , не более

0,35 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при  $I_K = 1 \text{ А}$ ,  $I_E = 0,2 \text{ А}$ , не более

1,3 В

Время включения при  $U_{КЭ} = 20 \text{ В}$ ,  $I_K = 1 \text{ А}$ ,  $I_E = 0,1 \text{ А}$ , не более

0,1\* мкс

типичное значение

0,025\* мкс

Время выключения при  $U_{КЭ} = 20 \text{ В}$ ,  $I_K = 1 \text{ А}$ ,  $I_E = 0,1 \text{ А}$ , не более

1\* мкс

типичное значение

0,2\* мкс

Время спада при  $U_{КЭ} = 20 \text{ В}$ ,  $I_K = 1 \text{ А}$ ,  $I_E = 0,1 \text{ А}$ , не более

0,1 мкс

Обратный ток коллектора при  $U_{КБ} = U_{КЕ}$  макс, не более:

$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$

0,1 мА

$T = +125 \text{ }^\circ\text{C}$

3 мА

Обратный ток эмиттера при  $U_{ЭБ} = 5 \text{ В}$ , не более

1 мА

Емкость коллекторного перехода при  $U_{КБ} = 5 \text{ В}$ , не более

150\* пФ

типичное значение

70\* пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{КБ} = 5 \text{ В}$ , не более

1000 пФ

типичное значение

600 пФ

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:

2Т860А	90 В
2Т860Б	70 В
2Т860В	40 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при  $R_{с.э} \leq 100 \text{ Ом}$ :

2Т860А	90 В
2Т860Б	70 В
2Т860В	40 В

Постоянное напряжение эмиттер — база

Постоянный ток коллектора	2 А
Импульсный ток коллектора	4 А
Постоянный ток базы	1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при  $T_{к} = -60...+25^{\circ}\text{C}$ :

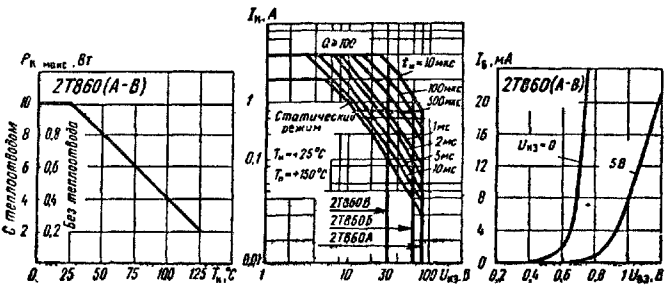
с теплоотводом	10 Вт
без теплоотвода	1 Вт

Температура p-n перехода

Температура окружающей среды	+150 °C
	-60 °C, $T_{к} = +125^{\circ}\text{C}$

При эксплуатации транзисторов необходимо принять меры, исключающие появление паразитной генерации.

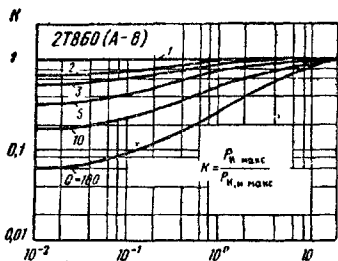
Допустимое значение статического потенциала 1 кВ.



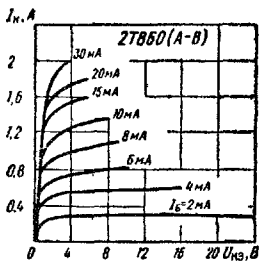
Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса

Области максимальных режимов

Входные характеристики



Зависимости коэффициента  $K$  от длительности импульса



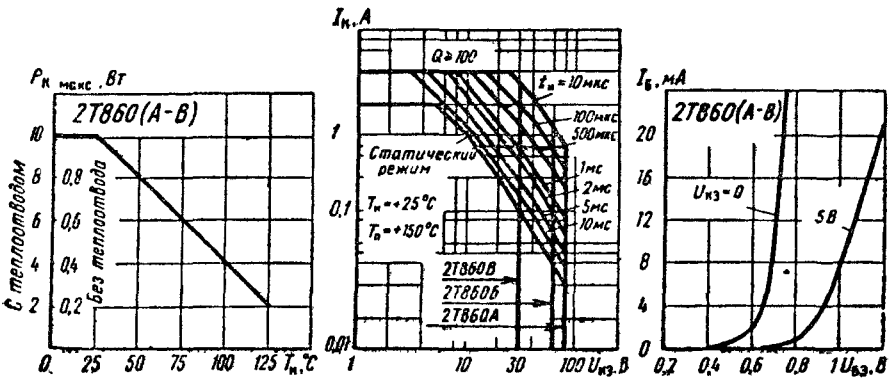
Выходные характеристики

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при  $R_{cэ} \ll \leq 100 \text{ Ом}$ :

2Т860А	90 В
2Т860Б	70 В
2Т860В	40 В
Постоянное напряжение эмиттер — база	5 В
Постоянный ток коллектора	2 А
Импульсный ток коллектора	4 А
Постоянный ток базы	1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_{\kappa} = -60 \dots +25 \text{ }^\circ\text{C}$ :	
с теплоотводом	10 Вт
без теплоотвода	1 Вт
Температура р-п перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-60 °С... $T_{\kappa} = +125 \text{ }^\circ\text{C}$

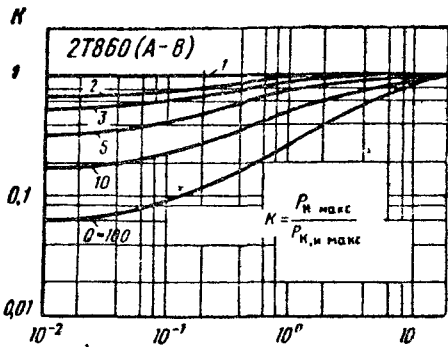
При эксплуатации транзисторов необходимо принять меры, исключающие появление паразитной генерации.

Допустимое значение статического потенциала 1 кВ.

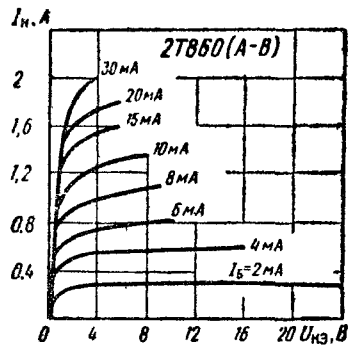


Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса

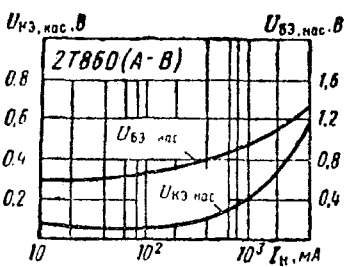
Области максимальных Выходные характеристики режимов



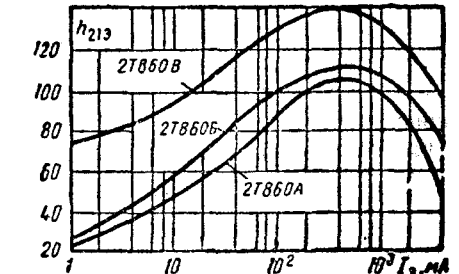
Зависимости коэффициента  $K$  от длительности импульса



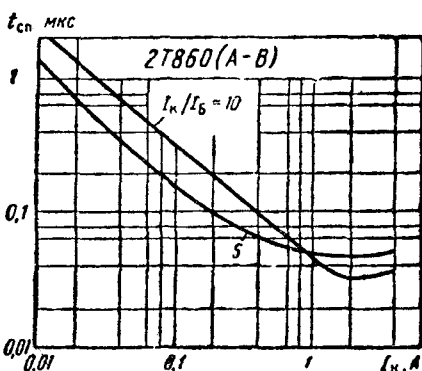
Выходные характеристики



Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока коллектора



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости времени спада от тока коллектора